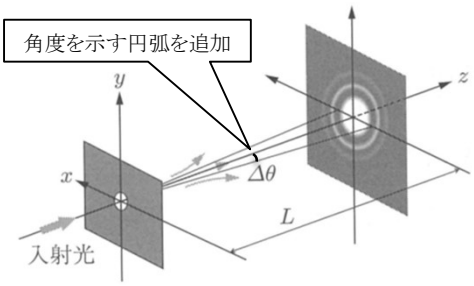
「フォトニクスの基礎」正誤表（初版第1刷）

頁	行・式	誤	正
15	式(1.34a)	$\boldsymbol{S}_{av}=\frac{nE_0^2}{\eta_0}\boldsymbol{s}$	$\boldsymbol{S}_{av}=\frac{nE_0^2}{2\eta_0}\boldsymbol{s}$
18	下から3～2	透過係数tが減少することがわかる。	反射係数rの絶対値が大きくなる。
23	図2.6 横軸	0　1　2　3　4	−1　0　1　2　3
23	図2.6 縦軸	0.1	0
30	図2.15	下図	
40	図3.4 キャプション	各モードの	TE波
40	図3.4 横軸	TE_0　TE_1　TE_2	m=0　m=1　m=2
49	4	次式が解となる。	次式が解の一つとなる。
51	3	2.41	2.40
51	式(3.31)	2.41	2.40
55	式(4.3) 2行目	$=E_{in}\sin$	$=-jE_{in}\sin$
59	下から3～2	a　b　c　（イタリック）	a　b　c　（立体）
123	12	周波数広がりが f_k	周波数広がりの最大値が f_k
127	10	電界強度	電界振幅
130	4	印加電圧	印加電界
130	下から7	c　（イタリック）	c　（立体）
131	式(7.27)	Φ　（立体）	Φ　（イタリック）
133	式(7.36)中辺の 分子	$1+\cos 2\varphi$	$1+\cos 2\Delta\varphi$
156	3,4（3か所）	domain	division
160	下から 2	非線性	非線形性
166	式(8.32)	$Q=\cos\left(N\frac{\pi}{2}+\delta\right)$	$Q=\sin\left(N\frac{\pi}{2}+\delta\right)$
181	引用・参考文献3)	光エレクトロニクス入門	光エレクトロニクス
183	4章【1】	$\frac{\lambda_0}{nd\alpha}$	$\frac{\lambda_0}{(n-1)d\alpha}$
184	8章【6】 4行目	1200	1260
184	8章【6】 5行目	$\frac{299792458}{1200\times10^{-9}}=249.827\times10^{12}$	$\frac{299792458}{1260\times10^{-9}}=237.931\times10^{12}$
184	8章【6】 5行目	249.827	237.931
184	8章【6】 6行目	49.965	61.861
184	8章【6】 6行目	499	618